ВИЗНАЧЕННЯ ВНЕСЕНИХ ОПОРІВ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ ВИХРОСТРУМОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА З КОНТРОЛЬОВАНИМ ФЕРОМАГНІТНИМ ЗРАЗКОМ

© Мартинов В.В., Трушаков Д.В., 2008

Наведено результати теоретичних досліджень взаємодії накладного вихрострумового перетворювача з П-подібним магнітопроводом та контрольованого феромагнітного матеріалу. Отримано формули для інженерного розрахунку внесених у вихрострумовий перетворювач активного та реактивного опорів у разі його взаємодії з контрольованим феромагнітним зразком. Результати досліджень можна використовувати у вихрострумовій дефектоскопії.

In the work there has been presented the results of theoretical research of interaction between a laying-in U-type core eddy-current transformer and tested ferromagnetic material. Received equations for engineering calculation of introduced real resistance and reactance in eddy-current transformer which interacting with testing ferromagnetic material. The results of this research can be used for eddy-current defectoscopy.

Постановка проблеми. Характер взаємодії вихрострумового перетворювача (ВСП) з провідним середовищем під час виконання дефектоскопії феромагнітних деталей та вузлів на практиці визначити важко. Це зумовлено складним математичним апаратом, що використовується для опису цієї взаємодії. Особливо складно описується взаємодія ВСП з П-подібним магнітопроводом та контрольованим феромагнітним зразком.

Аналіз останніх досліджень у цьому напрямку вихрострумової дефектоскопії дає змогу дійти висновку, що досі проблему повністю ще не вирішено. Цю проблему було розглянуто в роботах [1–3].

Задачі дослідження. У цій роботі дослідження спрямоване на одержання формул для внесених опорів П-подібного ВСП у разі його взаємодії з феромагнітним зразком, враховуючи закони



Рис. 1. Уявлений вигляд контрольованого феромагнітного зразка у вигляді пластини, що знаходиться під полюсами П-подібного ВСП

електромагнітного поля і теорії електричних кіл. У цих дослідженнях математична модель взаємодії ВСП та контрольованого феромагнітного зразка розроблена з врахуванням взаємної індукції зразка та обмотки ВСП. Натомість, у попередніх дослідженнях [3] математична модель ґрунтувалася на взаємодії електромагнітних полів обмотки ВСП з феромагнітним зразком.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо взаємодію П-подібного ВСП із феромагнітною пластиною (рис. 1).

Нехтуючи потоком розсіювання, визначимо магнітний потік в осерді ВСП і контрольованій області:

$$\Phi = \frac{WI}{\sum R_{M}},\tag{1}$$

де w – кількість витків обмотки ВСП; I – діюче значення струму; $\sum R_{M}$ – сума магнітних опорів ділянок.

Магнітна індукція у контрольованій ділянці зразка

$$B = \frac{\Phi}{S_3},\tag{2}$$

де S₃ – площа поперечного перерізу в контрольованій ділянці під ВСП.

Напруженість магнітного поля в контрольованій ділянці

$$H = \frac{B}{m_3 m_0},\tag{3}$$

де m_0 – відносна магнітна проникність матеріалу зразка; $m_0 = 4p \cdot 10^{-7} \Gamma_{H/M}$ – стала величина.

Магнітний потік в контрольованій ділянці створений струмом обмотки ВСП, тому щодо контрольованої ділянки його можна розглядати як потік взаємної індукції, тобто

$$\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{M} \cdot \boldsymbol{I} \,, \tag{4}$$

де M – коефіцієнт взаємної індукції обмотки ВСП і контрольованої ділянки.

Із виразу (4) маємо

$$M = \frac{\Phi}{I} \,. \tag{5}$$

Підставивши вираз (1) в вираз (5), отримаємо

$$M = \frac{W}{\sum R_{M}} \,. \tag{6}$$

Як відомо [4], напруженості електричного і магнітного полів у контрольованому середовищі зв'язані співвідношенням

$$E = \underline{Z}_{_{\mathcal{B}H}} \cdot H , \qquad (7)$$

де <u>Z</u>_{вн} – хвильовий опір матеріалу контрольованої ділянки.

Цей опір визначається властивостями середовища і частотою струму в обмотці ВСП [4]:

$$\underline{Z}_{_{GH}} = \sqrt{\frac{j \, w m_a}{g}} \,, \tag{8}$$

де w – циклічна або кругова частоти струму обмотки ВСП; $m_a = m_3 \cdot m_0$ – абсолютна магнітна проникність матеріалу контрольованої ділянки; γ – питома провідність цього матеріалу.

Підставивши вирази (8) і (3) в вираз (7), одержимо:

$$\dot{E} = \sqrt{\frac{jw}{gm_3m_0}} \cdot \frac{\Phi}{S_3} \,. \tag{9}$$

Комплексна потужність, яка виділяється в контрольованій ділянці, визначається виразом [4]:

$$\underline{S} = \int_{V} g E^{2} dV + j 2 w \int_{V} \left(\frac{m_{a} H^{2}}{2} - \frac{e_{0} E^{2}}{2} \right) dV .$$
(10)

Перший доданок у виразі (10) зображає втрати від вихрових струмів, а другий – реактивну потужність.

Визначимо активну і реактивну складові потужності, вважаючи контрольовану ділянку паралелепіпедом з об'ємом $V_3 = S_3 \cdot l$, де l – довжина контрольованої ділянки:

$$P = gE^2 V_3 = \frac{w\Phi^2 l}{m_3 m_0 S_3},\tag{11}$$

$$Q = \frac{w\Phi^2 l}{m_3 m_0 S_3} \left(l - \frac{we_0}{g} \right).$$
(12)

Отже, в контрольованій ділянці виділяється комплексна потужність

$$\underline{S} = P + jQ = \frac{w\Phi^2 l}{m_3 m_0 S_3} + j \frac{w\Phi^2 l}{m_3 m_0 S_3} \left(l - \frac{we_0}{g} \right).$$
(13)

З іншого боку <u>S</u> можна визначити так [4]:

$$\underline{S} = \frac{U^2}{\frac{x}{Z}},\tag{14}$$

де *U* – напруга на кінцях контрольованої ділянки; <u>Z</u> – спряжений комплексний опір контрольованої ділянки.

Із виразу (14) цей опір визначається так:

$$\frac{\overset{*}{Z}}{\underline{Z}} = \frac{U^2}{S} \,. \tag{15}$$

Напругу, яка виникає між кінцями контрольованої ділянки, вважаючи цю ділянку провідником, розміщеним у змінному магнітному полі, визначають за виразом [4]:

$$U = j w \Phi_{\perp} \tag{16}$$

Підставивши в вираз (15) вирази (16) і (13), отримаємо

$$\underbrace{\overset{*}{\underline{Z}}}_{=} = \frac{w^2 \Phi^2}{\frac{w \Phi^2 l}{m_3 m_0 S_3} \left(l + j \left(l - \frac{w e_0}{g} \right) \right)}.$$
(17)

Після скорочення і перетворення дробу у виразі (17) маємо

$$\frac{Z}{Z} = \frac{Wm_{3}m_{0}S_{3}}{l\left(1 + j\left(1 - \frac{We_{0}}{g}\right)\right)}.$$
(18)

Позбувшись комплексного числа у знаменнику, одержимо

$$\frac{\overset{*}{Z}}{\underline{Z}} = \frac{wm_{3}m_{0}S_{3}\left(1 - j\left(1 - \frac{we_{0}}{g}\right)\right)}{l\left(1 + \left(1 - \frac{we_{0}}{g}\right)^{2}\right)}.$$
(19)

Комплексний опір контрольованої ділянки визначаємо за виразом

$$\underline{Z} = \frac{wm_{3}m_{0}S_{3}\left(1+j\left(1-\frac{we_{0}}{g}\right)\right)}{l\left(1+\left(1-\frac{we_{0}}{g}\right)^{2}\right)}.$$
(20)

Активний і реактивний опори контрольованої ділянки

$$R = \frac{wm_{3}m_{0}S_{3}}{l\left(1 + \left(1 - \frac{we_{0}}{g}\right)^{2}\right)},$$
(21)

$$X = \frac{\mathbf{wm}_{3} \mathbf{m}_{0} S_{3} \left(1 - \frac{\mathbf{we}_{0}}{g} \right)}{l \left(1 + \left(1 - \frac{\mathbf{we}_{0}}{g} \right)^{2} \right)}.$$
(22)

Під впливом контрольованої ділянки опір обмотки ВСП змінюється на величину [5]:

$$R_{_{6H}} = \frac{w^2 M^2 R}{R^2 + X^2}; \quad X_{_{6H}} = -\frac{w^2 M^2 X}{R^2 + X^2}, \tag{23}$$

де $R_{\scriptscriptstyle 6H}$, $X_{\scriptscriptstyle 6H}$ – внесені активний і реактивний опори.

Підставивши в вираз (23) вирази (6),(21) і (22) і виконавши перетворення, одержимо співвідношення для обчислення внесених контрольованою ділянкою активного і реактивного опорів:

$$R_{_{GH}} = \frac{W w^2 l}{m_{_3} m_0 S_{_3} \left(\sum R_{_M}\right)^2},\tag{24}$$

$$X_{_{GH}} = \frac{-w_W^2 l(1 - \frac{we_0}{g})}{m_3 m_0 S_3 (\sum R_{_M})^2}.$$
(25)

Оцінимо порядок величини $\frac{we_0}{g}$. Для цього із довідників виберемо значення $g = 7,692 \cdot 10^6 O M^{-1} M^{-1}$; $e_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\Phi}{M}$, тоді одержимо $\frac{W e_0}{g} = 7,232 \cdot 10^{-18} \cdot f$. Якщо робоча

частота досягає сотень мегагерц, ця величина буде дуже малою, порядку 10^{-10} , і нею можна знехтувати, тобто виходить, що

$$\left|R_{_{6H}}\right| = \left|X_{_{6H}}\right|. \tag{26}$$

Вирази (24),(25) для обчислення внесених активного і реактивного опорів одержані, враховуючи припущення, що магнітне поле, створене ВСП, зосереджується в об'ємі паралелепіпеда, обмеженого розмірами магнітного осердя ВСП. Зважаючи на те, що розміри виробу, який контролюється, більші від розмірів цього осердя, магнітне поле в контрольованій ділянці може займати об'єм, більший за об'єм $V_3 = S_3 l$. Це збільшення об'єму магнітного поля зумовлено тим, що змінне електромагнітне поле в об'ємі V_3 наводитиме електромагнітне поле в ділянках, прилеглих до об'єму V₃. Розміри цих ділянок, відраховані від граней паралепіпеда, необхідно вважати такими, що дорівнюють глибині проникнення електромагнітного поля у досліджуваний феромагнітний зразок [4]:

$$D = \sqrt{\frac{2}{wm_{3}m_{0}g}} .$$
 (27)

Якщо в вираз (27) підставити значення $m_0 = 4p \cdot 10^{-7} \frac{\Gamma_H}{M}$, $g = 7.962 \cdot 10^6 O_M m^{-1} M^{-1}$ і w = 2pf,

одержимо

$$D = \frac{0.181468184}{\sqrt{m_3 f}},$$
(28)

де m_{f} – відносна магнітна проникність контрольованого матеріалу; f – робоча частота ВСП.

Для феромагнітних матеріалів т може мати значення від декількох одиниць до сотень одиниць. Тому при $m_{i}=10$ і $f=10^{3} \Gamma u$ глибина проникнення електромагнітного поля в контрольований феромагнітний зразок: D = 0,00181468184 м, тобто, близько 2 мм. Із збільшенням робочої частоти глибина проникнення D зменшуватиметься.

Формула для обчислення R_{вн} і Х_{вн} з врахуванням збільшення об'єму, зайнятого магнітним полем, матиме вигляд

$$R_{_{GH}}^{'} = X_{_{GH}}^{'} = \frac{WW^{2}(l+2D)}{m_{_{3}}m_{_{0}}(S_{_{3}}+2D\cdot h)(\sum R_{_{M}})^{2}},$$
(29)

де *h* – товщина контрольованого об'єкта.

Площа поперечного перерізу $S_3 = bh$, тому

$$R_{_{\theta H}}^{'} = X_{_{\theta H}}^{'} = \frac{W W^{2} l \left(1 + \frac{2D}{l} \right)}{m_{_{3}} m_{_{0}} S_{_{3}} \left(1 + \frac{2D}{b} \right) (\sum R_{_{M}})^{2}} = R_{_{\theta H}} \frac{1 + \frac{2D}{l}}{1 + \frac{2D}{b}},$$
(30)

де $R_{_{6H}}$ визначається за виразом (24).

Розглянемо відношення $\frac{R_{_{\theta H}}}{R_{_{\theta H}}}$:

$$\frac{R_{_{BH}}}{R_{_{BH}}} = \frac{1 + \frac{2D}{l}}{1 + \frac{2D}{h}}.$$
(31)

Як зрозуміло із виразу (31) $\frac{R_{_{6H}}^{'}}{R_{_{6H}}}$ залежить від частоти і властивостей матеріалу контрольованої ділянки (D) і розмірів ВСП (l, b). Тому під час визначення внесених опорів обчислюється R_{en} за виразом (24), знаходимо відношення $\frac{R_{en}}{R}$ за виразом (31) і вносимо поправку

на збільшення об'єму V₃. У разі зростання робочої частоти D зменшується і відношення

наближаючись до одиниці.

Висновки. За виконаними теоретичними дослідженнями були отримані такі результати: 1) одержані вирази для визначення внесених активного та реактивного опорів у разі взаємодії вихрострумового перетворювача з П-подібним магнітопроводом та контрольованого феромагнітного зразка, враховуючи закони електромагнітного поля і теорії електромагнітних кіл з врахуванням взаємної індукції зразка та обмотки вихрострумового перетворювача; 2) знайдено коефіцієнт, який враховує вплив глибини проникнення електромагнітних хвиль на величину внесених опорів. Отримані вирази можна використати у вихрострумовій дефектоскопії феромагнітних виробів.

1. Гамалий В., Трушаков Д. Моделювання вихорострумового перетворювача з П-подібним магнітопроводом, розташованого над феромагнітним зразком із тріщиною // Теор. Електротехніка. – 2005. – Вип. 58. – С. 176–182. 2. Смірнов Б.Г., Трушаков Д.В. Електромагнітні явища в вихрострумовому перетворювачі під час його взаємодії з феромагнітним зразком // Вісн. Нац. *ун-ту* "Львівська політехніка". – 2006. – № 563. – С. 127–134. 3. Мартинов В., Трушаков Д. Моделювання фізичних процесів в вихрострумовому перетворювачі при його взаємодії з контрольованим феромагнітним зразком // Теор. електротехніка. — 2006. — Вип. 59. 4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Высш. шк., 1996. – 623 с. 5. Основы теории цепей / Г.В. Зевеке, П.А.Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов. – М.: Энергия, 1975. – 752 с.